1. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr Signals Markedly Enhanced by Increasing Quality Factor in a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.4,* 04DG02, 2011.
2. **Fumiya Tanaka, Toshikazu Takimoto, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-Resolved Measurements on Sum-Frequency Generation Strongly Enhanced in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.4,* 04DG03, 2011.
3. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel terahertz emission devices based on efficient optical frequency conversion in GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures on high-index substrates, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7937,** 1H-1, 2011.
4. **Takahiro Kitada, Tomoya Takahashi, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked reduction in photocarrier lifetime by erbium doping into self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.323,** *No.1,* 241-243, 2011.
5. **Takuro Tomita, Ryota Kumai, Hidenori Nomura, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Surface roughness assisted 100 kHz femtosecond laser induced nanostructure formation on silicon surface, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.105,** *No.1,* 89-94, 2011.
6. **Takae Yamashita, Osamu Kojima, Takashi Kita *and* Toshiro Isu :** Depolarization effect on optical control of excition states confined in GaAs thin films, *Journal of Applied Physics,* **Vol.110,** *No.4,* 043514, 2011.
7. **Ken Morita, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Fumiya Tanaka, Yoshinori Nakagawa, Shingo Saito, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Generation of Terahertz Radiation from Two Cavity Modes of a GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Applied Physics Express,* **Vol.4,** *No.10,* 102102, 2011.
8. **Shohei Ohta, Osamu Kojima, Takashi Kita *and* Toshiro Isu :** Observation of quantum beat oscillations and ultrafast relaxation of excitons confined in GaAs thin films by controlling probe laser pulses, *Journal of Applied Physics,* **Vol.111,** 023505, 2012.
9. **Takuto Ito, Manato Deki, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Oshima :** Electrical conduction properties of SiC modified by femtosecond laser, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.7,** *No.1,* 16-20, 2012.
10. **Haruyoshi Katayama, Junpei Murooka, Masataka Naitoh, Tadashi Imai, Ryota Sato, Eichi Tomita, Munetaka Ueno, Hiroshi Murakami, Satoshi Kawasaki, Kunihiko Bito, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin *and* Iwao Hosako :** Development of type II superlattice detector for future space applications at JAXA, *Proceedings of SPIE,* **Vol.8353,** 2012.
11. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Michael Flockert, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface plasmon excitation by 2D-hexagonal plasmonic crystal, *The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5) 2011,* **Vol.MP-14,** Busan, May 2011.
12. **Flockert Michael, Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** 2D-gap mode plasmonic crystal on photonic fiber end face, *The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5) 2011,* **Vol.TuP-126,** Busan, May 2011.
13. **Ken Morita, Toshikazu Takimoto, Shou Katoh, Fumiya Tanaka, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with polarization inverted structure fabricated by wafer-bonding method, *The 38th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2011), No.P4.102,* Berlin, Germany Maritim proArte Hotel, May 2011.
14. **Shimpei Tanabe, Yoshinori Nakagwa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Chirped grating coupler for surface plasmon polariton excitation fabricated by scanning probe microscope lithography, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Nanophotonics and Near-Field Optics( APNFO),* Adelaide, Aug. 2011.
15. **Hiroaki Suzuki, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Toshihiro Okamoto :** Emission spectra from nano slit arrays on a LED electrode, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Nanophotonics and Near-Field Optics( APNFO),* Adelaide, Aug. 2011.
16. **Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz radiation from a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity by ultrashort laser pulse excitation, *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2011), No.I-4-2,* Nagoya, Sep. 2011.
17. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast all-optical switches, *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2011), No.I-5-1,* Nagoya, Sep. 2011.
18. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属膜上の多重スリットによるLED光取り出し制御, *LED総合フォーラム論文集,* 77-78, 2011年6月.
19. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Optical properties of Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers for an all-optical switch with a multilayer cavity structure, *第30回電子材料シンホ シ ウム(EMS-30), No.Th1-8,* 2011年6月.
20. **Syo Katoh, Toshikazu Takimoto, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Terahertz Difference-frequency Generation of two cavity modes in a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *第30回電子材料シンホ シ ウム(EMS-30), No.Th1-17,* 2011年6月.
21. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 遠藤 善紀, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 二次元六方プラズモン結合器の励起光波長依存性, *応用物理学会 中国四国支部 2011年度 支部学術講演会, No.Bp2-3,* 2011年7月.
22. **遠藤 善紀, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 田邉 新平, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** ツインリッジプラズモン導波路の作製と評価, *応用物理学会 中国四国支部 2011年度 支部学術講演会, No.Bp2-4,* 2011年7月.
23. **安長 千徳, 上山 日向, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜三結合共振器構造を用いた四光波混合による波長変換素子, *2011年度応用物理学会中国四国支部学術講演会, No.Bp2-1,* 2011年7月.
24. **張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/Air 微小光共振器構造の選択エッチングによる作製, *2011年度応用物理学会中国四国支部学術講演会, No.Ea2-4,* 2011年7月.
25. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** 表面プラズモンポラリトン広角励起用チャープグレーティングの作製, *第72回応用物理学会学術講演会,* **Vol.30p-P13-24,** 2011年8月.
26. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射偏光依存性Ⅱ, *第72回応用物理学会学術講演会,* 04-236, 2011年8月.
27. **北田 貴弘, 滝本 隼主, 加藤 翔, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs結合共振器に生じる非線形分極とテラヘルツ帯差周波発生, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31a-F-6,* 04-135, 2011年8月.
28. **森田 健, 加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs結合共振器における二つの共振器モードを利用したテラヘルツ帯差周波発生, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31a-F-7,* 04-136, 2011年8月.
29. **滝本 隼主, 加藤 翔, 田中 文也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器のテラヘルツ帯差周波発生の分極反転効果, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-6,* 14-037, 2011年8月.
30. **張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速光スイッチに向けたGaAs/Air 共振器構造の作製, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-5,* 14-036, 2011年8月.
31. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 波長変換機能を実現するGaAs/AlAs多層膜三結合共振器中の非線形分極, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-4,* 14-035, 2011年8月.
32. **小島 磨, 山下 太香恵, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中の光電場に対する局所場の効果, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-3,* 14-034, 2011年8月.
33. **上山 日向, 高橋 朋也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器の作製と光学特性, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1a-ZA-15,* 15-108, 2011年9月.
34. **加藤 翔, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造におけるテラヘルツ帯差周波信号の励起偏光方向依存性, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1p-ZN-4,* 05-073, 2011年9月.
35. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 非共鳴励起下における励起子ポラリトンと光電場の結合, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1p-K-9,* 14-071, 2011年9月.
36. **五井 恵太, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子状態の光制御に対する入射光エネルギー依存性, *2011年秋季大会 日本物理学会, No.21aRB-9,* 2011年9月.
37. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ波発生素子, *学振第182委員会第11回研究会 (テラヘルツ波科学技術と産業開拓委員会),* 2011年10月.
38. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 遠藤 善紀, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 楕円型回折格子による表面プラズモンポラリトン励起, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2011, No.29aE2,* 2011年11月.
39. **遠藤 善紀, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 田邉 新平, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 交差回折格子結合器によるSPP の二色性励起, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2011, No.29aE3,* 2011年11月.
40. **井須 俊郎 :** 半導体ナノ構造による新規光デバイスの創製, *精密工学会知能メカトロニクス専門委員会研究会,* **Vol.16,** *No.3,* 13, 2012年1月.
41. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健, 中河 義典 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ発光素子, *(社)レ-ザー学会学術講演会第32回年次大会, No.F-431pIV01,* 169, 2012年1月.
42. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ波発生, *第7回宇宙用高感度赤外センサ研究会,* 2012年2月.
43. **森田 健, 上山 日向, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加したInAs量子ドットをもつGaAs/AlAs多層膜光共振器による超高速全光スイッチ, *光エレクトロニクス研究会(OPE),* **Vol.111,** *No.448-449,* 31-34, 2012年3月.
44. **伊藤 拓人, 大西 諒, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射による表面及び内部におけるSiC 改質部の電気伝導特性, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会,* 04-283, 2012年3月.
45. **上山 日向, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットを1層有するGaAs/AlAs多層膜共振器のMBE成長, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-A8-8,* 2012年3月.
46. **北田 貴弘, 滝本 隼主, 加藤 翔, 森田 健, 井須 俊郎 :** 超短パルス光照射によるGaAs/AlAs結合共振器からのテラヘル帯差周波発生とそのシミュレーション, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-GP6-10,* 2012年3月.
47. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン広範励起用チャープグレーティングの作製, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-GP1-20,* 2012年3月.
48. **上山 日向, 安長 千徳, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜共振器の四光波混合信号測定, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.17a-E1-7,* 2012年3月.
49. **森田 健, 滝本 隼主, 加藤 翔, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分極反転したGaAs/AlAs結合共振器によるテラヘルツ帯差周波発生, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.18a-E8-11,* 2012年3月.
50. **井須 俊郎 :** テラヘルツLEDの実現を目指して, *第10回徳島大学研究者との集い(産学連携講演会),* 2011年11月.
51. **井須 俊郎 :** 半導体ナノ構造を使った新しい光デバイス技術開発∼未開拓の光発生素子を目指して∼, *LED・エネルギー市民フォーラム,* 2011年12月.
52. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs Multilayer Cavity with Er-Doped InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Barriers for Ultrafast All-Optical Switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.51,** *No.4,* 04DG06, 2012.
53. **Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz Radiation from a (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity by Ultrashort Laser Pulse Excitation, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.51,** *No.4,* 04DG05, 2012.
54. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton grating coupler on the Ti diffused LiNbO3 channel waveguide, *World Academy of Science, Engineering and Technology,* **Vol.71,** 798-807, 2012.
55. **Ken Morita, Hyuga Ueyama, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in extremely thin strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast all-optical switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG04, 2013.
56. **Hidetada Komatsu, Zhao Zhang, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/Air Multilayer Cavity for a Planar-Type Nonlinear Optical Device, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG06, 2013.
57. **Ken Morita, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz radiation using a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *The 10th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter, Nanostructured and Molecular Materials(EXCON2012),* **Vol.P073,** Groningen, the Netherlands, Jul. 2012.
58. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton Grating Coupler on Piezoelectric Material Bonded with Conductive Si (100) Substrate, *Abstract of the 12-th international Conference on Near-field Optics nanophotonics and Related Techniques (NFO-12),* 110, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, Sep. 2012.
59. **Takahiro Kitada, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Ultrafast photocarrier relaxation processes in Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *The 17th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE 2012), No.TuP-53,* Nara, Sep. 2012.
60. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strongly enhanced four-wave mixing signal from GaAs/AlAs cavity with InAs QDs embedded in strain-relaxed barriers, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.A-3-2,* Kyoto, Sep. 2012.
61. **Hidetada Komatsu, Zhao Zhang, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/Air multilayer cavity for a planar-type non-linear optical device, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.PS-7-19,* Kyoto, Sep. 2012.
62. **Ken Morita, Hyuga Ueyama, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in extremely thin strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast alloptical switches, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.A-6-4,* Kyoto, Sep. 2012.
63. **S Katoh, Y Yasunaga, Y Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs barriers on (113)B GaAs substrates, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.P2-084,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
64. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing signal measurements of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs QDs embedded in strain-relaxed barriers, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.P2-105,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
65. **Takahiro Kitada, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel semiconductor quantum dots for ultrafast nonlinear optical devices, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.4C-IL-6,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
66. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton grating coupler on the Ti diffused LiNbO3 channel waveguide, *ICNOP 2012 : International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics,* Venice, Nov. 2012.
67. **Takahiro Kitada, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Molecular Beam Epitaxy of InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Ultrafast Nonlinear Optical Devices, *Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG), No.A7,* Orland, Florida, USA, Dec. 2012.
68. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication and optical evaluation of 1D and 2D photonic metamaterial crystal, *Photonics Global Conference 2012,* **Vol.c12a512,** Singapore, Dec. 2012.
69. **H Komatsu, Z Zhang, Y Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** A GaAs/Air multilayer cavity for a planar-type non-linear optical devise GaA/Air, *第31回電子材料シンポジウム(EMS-31), No.Fr1-8,* 2012年7月.
70. **Y Yasunaga, H Ueyama, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Strongly enhanced four-wave mixing signal from GaAs/AlAs cavity, *第31回電子材料シンポジウム(EMS-31), No.Fr1-9,* 2012年7月.
71. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドット共振器による四光波混合信号の増強, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Cp-4,* 2012年7月.
72. **小松 秀士, 張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜光共振器の反射率スペクトル測定, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Cp-3,* 2012年7月.
73. **田邉 新平, 中河 義典, 楠瀬 健, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** Ti 拡散LiNbO3 リッジ導波路上への表面プラズモンポラリトン励起用回折格子の作製, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Aa-8,* 2012年7月.
74. **北田 貴弘 :** 新規な非線形光学デバイスを目指した半導体ナノ構造のMBE成長, *和歌山大学-徳島大学 光・ナノテクノロジー研究会,* 2012年8月.
75. **森田 健 :** 半導体結合共振器による面型テラヘルツ波発生素子, *和歌山大学-徳島大学 光・ナノテクノロジー研究会,* 2012年8月.
76. **北田 貴弘, 上山 日向, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs 量子ドットにおける超高速キャリア緩和の励起波長依存性, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.11p-F1-1,* 2012年9月.
77. **森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 井須 俊郎 :** 通信波長帯多重積層InAs 量子ドット中のスピン緩和, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.11p-F1-2,* 2012年9月.
78. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 波長変換機能を実現するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の四光波混合信号の時間分解測定, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12a-F1-2,* 2012年9月.
79. **加藤 翔, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs基板上に作製した歪緩和In0.45Ga0.55Asバリア層に埋め込んだInAs量子ドット, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12a-J-9,* 2012年9月.
80. **富田 卓朗, 尾崎 信彦, 菅野 智士, 江山 剛史, 高吉 翔大, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs多重量子井戸におけるフェムト秒レーザーアブレーション, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12p-PA4-6,* 2012年9月.
81. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 単結晶ダイヤモンド基板上に作製された表面プラズモンポラリトン励起用回折格子型結合器の特性評価, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.13a-PA4-5,* 2012年9月.
82. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** LED の金属電極部に形成した回折格子構造による発光制御, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2012 講演予稿集, No.24pE3,* 2012年10月.
83. **森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器によるテラヘルツ光発生, *電子情報通信学会電子デバイス研究会, No.ED2012-96,* 17-21, 2012年12月.
84. **北田 貴弘, 原山 千穂, 森田 健, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 結合共振器による二波長面発光レーザの室温光励起発振, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.28a-G20-8,* 2013年3月.
85. **井須 俊郎 :** 超高速非線形光学デバイスと応用電子物性分科会, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.28p-G14-5,* 2013年3月.
86. **小松 秀士, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜共振器構造の反射率面内分布, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.30a-G20-12,* 2013年3月.
87. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strongly Enhanced Four-Wave Mixing Signal from GaAs/AlAs Cavity with InAs Quanynm Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG09, 2013.
88. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication and evaluation of photonic metamaterial crystal, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.112,** 613-619, 2013.
89. **Takahiro Kitada, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Terahertz Waveforms Generated by Second-Order Nonlinear Polarization in GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavities Using Ultrashort Laser Pulses, *IEEE Photonics Journal,* **Vol.5,** *No.3,* 6500308, 2013.
90. **Takahiro Kitada, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Terahertz emission from a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with nonlinear optical susceptibility inversion, *Applied Physics Letters,* **Vol.102,** *No.25,* 251118, 2013.
91. **Takahiro Kitada, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Ultrafast photocarrier relaxation processes in Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.378,** 485-488, 2013.
92. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Wavelength conversion via four-wave mixing in a triple-coupled multilayer cavity, *Applied Physics Letters,* **Vol.103,** *No.10,* 101109, 2013.
93. **Takahiro Kitada, Chiho Harayama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Two-color lasing in a coupled multilayer cavity with InAs quantum dots by optical pumping, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.10,** *No.11,* 1434-1437, 2013.
94. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in a GaAs/AlAs triple-coupled multilayer cavity for novel ultrafast wavelength conversion devices, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.4S,* 04EG03, 2014.
95. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Wafer-bonded coupled multilayer cavity with InAs quantum dots for two-color emission, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.4S,* 04EG11, 2014.
96. **Takahiro Kitada, Chiho Harayama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Two-Color Lasing in a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots by Optical Pumping, *The 40th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2013), No.TuC1-5,* Kobe Convention Center, Kobe, Japan, May 2013.
97. **Haruyoshi Katayama, Junpei Murooka, Ryota Sato, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin *and* Iwao Hosako :** Development of Type II Superlattice Detector for Future Space Applications in JAXA, *CLEO-PR & OECC/PS 2013, No.TuC1-3,* Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan, Jul. 2013.
98. **Hiroaki Suzuki, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Kohji Oshodani, Toshiro Isu *and* Masuo Fukui :** Emission from metal slit array on Laser Diode electrode through evanescent field scattering process, *The 9th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO2013),* 132, Singapore, Jul. 2013.
99. **Hiroaki Suzuki, Kohji Oshodani, Masanobu Haraguchi, Masuo Fukui, Toshiro Isu *and* Toshihiro Okamoto :** The light extraction control of the semiconduct or light-emitting devices using plasmonic structure, *Asia Student Photonics Conference 2013 (ASPC2013), No.P-40,* 70, Osaka, Jul. 2013.
100. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in a GaAs/AlAs triple-coupled multilayer cavity for novel ultrafast wavelength conversion devices, *2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2013), No.K-5-3,* Fukuoka, Sep. 2013.
101. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity by Wafer-Bonding for Two-Color Emission Devices, *2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2013), No.K-4-4,* Fukuoka, Sep. 2013.
102. **Hidetada Komatsu, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Clear observation of cavity mode of GaAs/air multilayer structure, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-3,* 2013年7月.
103. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Two-color lasing from wafer-bonded GaAs/AlAs coupled multilayer cavity by optical pumping, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-4,* 2013年7月.
104. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Terahertz emission from a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with self-assembled InAs quantum dots, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-8,* 2013年7月.
105. **Sho Katoh, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Optical properties of InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs barriers on (113)B GaAs substrate, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.Fr1-3,* 2013年7月.
106. **盧 翔孟, M Koyama, Y Izumi, S Adachi, S Muto :** Scaling behavior of InAlAs/AlGaAs quantum dots grown on GaAs by molecular beam epitaxy, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.Fr1-5,* 2013年7月.
107. **北田 貴弘, 盧 翔孟, 井須 俊郎 :** 量子ドット結合共振器による二波長レーザ∼新しいテラヘルツ光源を目指して, *第2回 和歌山大・徳島大合同光・ナノテクノロジー研究会,* 2013年8月.
108. **盧 翔孟, Satoru Adachi, Shunichi Muto :** Scaling Behavior of InAlAs/AlGaAs QDs Grown on GaAs by MBE, *第2回 和歌山大・徳島大合同光・ナノテクノロジー研究会,* 2013年8月.
109. **鈴木 裕旭, 大正谷 皓司, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫, 岡本 敏弘 :** プラズモニック構造による半導体発光デバイスの光取り出し制御, *第74回応用物理学会秋期学術講演会, No.17a-P12-14,* 2013年9月.
110. **大柄根 斉宣, 加藤 翔, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-D6-13,* 2013年9月.
111. **原山 千穂, 加藤 翔, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを利得媒質とするGaAs/AlAs結合共振器のウエハ直接結合による作製と光学特性評価, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-D6-14,* 2013年9月.
112. **小松 秀士, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 微小開口部アレイからの選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜共振器構造, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19a-D6-4,* 2013年9月.
113. **北田 貴弘, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs三結合共振器への波長帯域制限したパルス光照射による四光波混合信号光のスペクトル形状, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19a-D6-3,* 2013年9月.
114. **山内 諒, 盧 翔孟, 小山 正孝, 笹倉 弘理, 武藤 俊一 :** 2種類の拡散原子を有する量子ドット成長モデルでのスケール関数, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19p-D3-11,* 2013年9月.
115. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健, 盧 翔孟, 中河 義典 :** 半導体多層膜結合共振器構造の非線形光学応答とそのデバイス応用, *第9回量子ナノ材料セミナー,* 2013年11月.
116. **原口 雅宣, 鈴木 裕旭, 大正谷 浩司, 井須 俊郎, 岡本 敏弘, 福井 萬壽夫 :** プラズモン利用による発光デバイスの光取り出し制御, *レーザー学会学術講演会 第34回年次大会, No.22a I-3,* 2014年1月.
117. **北田 貴弘, 加藤 翔, 原山 千穂, 大柄根 斉宣, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 結合共振器によるテラヘルツ波発生への膜厚不均一の影響, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-2,* 2014年3月.
118. **大柄根 斉宣, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速波長変換素子に向けたInAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の作製, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-3,* 2014年3月.
119. **原山 千穂, 加藤 翔, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを利得媒質とするGaAs/AlAs結合共振器による等強度の二波長発振, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-4,* 2014年3月.
120. **盧 翔孟, 松原 修三, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分子線エピタキシーによる(001)と(113)B GaAs基板上に成長したInAs量子ドットのフォトルミネッセンスに与えるAlAsキャップの影響, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.18a-E15-1,* 2014年3月.
121. **森田 健, 小田 達也, 石谷 善博, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 通信波長帯InGaAs量子井戸中のスピン緩和, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.18a-E15-3,* 2014年3月.
122. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 半導体レーザの金属電極多重スリットによるレーザ光取出し制御, *LED総合フォーラム2013 in 徳島 論文集,* 57-58, 2013年4月.
123. **Haruyoshi Katayama, Michito Sakai, Junpei Murooka, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin, Iwao Hosako *and* Yasuhiro Iguchi :** Development Status of Type II Superlattice Infrared Detector in JAXA, *Sensors and Materials,* **Vol.26,** *No.4,* 225-234, 2014.
124. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** 04DG05, 2015.
125. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of cavity-layer thicknesses on two-color emission in coupled multilayer cavities with InAs quantum dots, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** 04DG10, 2015.
126. **R Yamauchi, Xiangmeng Lu, M Koyama, H Sasakura, Y Nakata *and* S Muto :** Volume distribution by quantum dot growth model with 2 kinds of diffusion atoms, *8th International Conference on Quantum Dots (QD 2014), No.M141,* Pisa, Italy, May 2014.
127. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of non-equivalent cavities on two-color lasing in a GaAs/AlAs coulpled multilayer cavity with InAs quantum dots, *The 41th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2014), No.P57,* Montpellier, France, May 2014.
128. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced photoluminescence form InAs quantum dots with a thin AlAs cap layer grown on (100) and (311)B GaAs substrate, *The 41th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2014), No.Tu-B3-4,* Montpellier, France, May 2014.
129. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Suppression of photoluminescence from wetting layer of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs with AlAs cap, *The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy(MBE2014), No.TuA2-5,* Flagstaff, Arizona, Sep. 2014.
130. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz Emission from a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots, *The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy(MBE2014), No.TuA2-2,* Flagstaff, Arizona, Sep. 2014.
131. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of Cavity-Layer Thicknesses on Two-Color Lasing in a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots, *2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014), No.B-3-3,* Tsukuba, Sep. 2014.
132. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots for an ultrafast wavelength conversion device via the four-wave-mixing, *2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014), No.PS-7-7,* Tsukuba, Sep. 2014.
133. **盧 翔孟, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Reduced wetting layer and enhanced photoluminescence of InAs quantum dots with AlAs cap grown on (113)B GaAs by molecular beam epitaxy, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Th2-14,* 2014年7月.
134. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Effect of thickness difference between two cavity layers on two-color lasing in a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with InAs quantum dots, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-16,* 2014年7月.
135. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots for novel ultrafast wavelength conversion devices, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-15,* 2014年7月.
136. **Keisuke Murakumo, Hidetada Komatsu, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Fabrication of a cavity structure with an air layer by selective etching and wafer-bonding, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-11,* 2014年7月.
137. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 中河 義典, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Effects of AlAs cap and InGaAs Layer on optical property of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs by molecular beam epitaxy, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-1,* 2014年7月.
138. **原山 千穂, 上原 敏弘, 中河 義典, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 量子ドット結合共振器による二波長面発光レーザ構造の作製, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-2,* 2014年7月.
139. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪柔和InGaAs層に埋め込んだErドープInAsQDsの内面光伝導特性, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-3,* 2014年7月.
140. **大正谷 皓司, 村中 隆二, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** LED 表面の金属電極に設けたマルチスリットによる光取り出し特性, *2014年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会, No.Ea-4,* 2014年7月.
141. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速キャリア緩和InAs 量子ドット積層構造の面内光伝導, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18a-A27-6,* 2014年9月.
142. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs/InGaAs量子ドット積層構造の面内光伝導特性の異方性, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A20-13,* 2014年9月.
143. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 中河 義典, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** AlAsキャップ付InAs量子ドットのフォトルミネツセンスに対するInGaAs層の影響, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A20-16,* 2014年9月.
144. **北田 貴弘, 原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 高田 博文, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** MBE成長とウエハ接合により作製したpn接合を含む量子ドット結合共振器, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-2,* 2014年9月.
145. **大柄根 斉宣, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の四光波混合信号測定, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-3,* 2014年9月.
146. **原山 千穂, 上原 敏弘, 中河 義典, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを含むGaAs/AlGaAs結合共振器の電流注入による二波長発光, *2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-4,* 2014年9月.
147. **森田 健, Ryota Kurosawa, Tatsuya Oda, Yoshihiro Ishitani, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Room temperature spin relaxation in InGaAs quantum wells, *2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.19P-S2-11,* 2014年9月.
148. **北田 貴弘, 井須 俊郎, 森田 健 :** ウエハ接合による結合共振器の作製とテラヘルツ波発生素子への応用, *第5回集積光デバイス技術研究会(IPDA),* 2014年12月.
149. **北田 貴弘, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 二波長面発光レーザーによるテラヘルツ波発生, *レーザー学会第472回研究会,* 2014年12月.
150. **原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 結合共振器構造による二波長面発光とテラヘルツ波発光素子, *電子情報通信学会研究会(レーザ・量子エレクトロニクス研究会LQE),* **Vol.48,** 2015年1月.
151. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs基板上に成長した量子ドットのPLの温度依存性, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.11a-A10-9,* 2015年3月.
152. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドット積層構造の面内光伝導キャリアの移動度, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.11a-A10-10,* 2015年3月.
153. **北田 貴弘, 原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12a-A10-9,* 2015年3月.
154. **大柄根 斉宣, 高本 俊昭, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生 (II), *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A14-4,* 2015年3月.
155. **村雲 圭佑, 山岡 裕也, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 量子ドット光伝導スイッチのメサ加工による暗電流の抑制, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A14-12,* 2015年3月.
156. **原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光レーザ構造の作製, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A17-8,* 2015年3月.
157. **大正谷 皓司, 村中 隆二, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属マルチスリットを組み合わせたLED 構造による表面プラズモンポラリトン発生素子の検討, *第62回応用物理学会春季学術講演会, No.13p-P3-18,* 2015年3月.
158. **北田 貴弘, 原山 千穂, 森田 健, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** テラヘルツLED, *LED総合フォーラム2014-2015,* 2015年1月.
159. **井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ光発生素子, *神戸大学フォトニック材料学セミナー,* 2015年1月.
160. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Suppression of photoluminescence from wetting layer of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs with AlAs cap, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.425,** 106-109, 2015.
161. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz emission from a coupled multilayer cavity with InAs quantum dots, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.425,** 303-306, 2015.
162. **Hiroto Ota, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of two-color surface emitting device of a coupled cavity structure with InAs QDs formed by wafer-bonding, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.4S,* 04EH09, 2016.
163. **Keisuke Murakumo, Yuya Yamaoka, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoconductivity of Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs layers with 1.5mm cw and pulse excitation, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.4S,* 04EH12, 2016.
164. **Xiangmeng Lu, Akihiro Kawaguchi, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Temperature Dependence Photoluminescence From InAs Quantum Dots With AlAs Cap Grown on (311)B and (100) GaAs Substrate, *The 42th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2015), No.Mo3GN1.5,* Santa Barbara, CA USA, Jun. 2015.
165. **Keisuke Murakumo, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** In-plane photoconductivity of InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs layer, *The 42th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2015), No.Mo3GN1.2,* Santa Barbara, CA USA, Jun. 2015.
166. **Naoto Kumagai, Keisuke Murakumo, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Mobility of in-plane photocurrent of stacked InAs QDs layers in strain-relaxed InGaAs matrix, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Mo-PM-14,* Sendai, Jul. 2015.
167. **Xiangmeng Lu, Akihiro Kawaguchi, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Investigation of Carriers Thermal Transfer in Self-asssembled Quantum Dots Grown on (311)B GaAs by Temperature Dependence Photoluminescence, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Th-PM-13,* Sendai, Jul. 2015.
168. **Shunicni Muto, Ryo Yamauchi, Osamu Muramatsu, Xiangmeng Lu, Masataka Koyama, Yoshiaki Nakata *and* Hirotaka Sasakura :** 2D Islands by growth model with 2 kinds of diffusive atoms, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Th-PM-3,* Sendai, Jul. 2015.
169. **Takahiro Kitada, Masanori Ogarane, Toshiaki Takamoto, Naoto Kumagai, Xiangmeng Lu, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Enhancement of Terahertz Emission from GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavities by InAs Quantum Dots on (113)B-Oriented Substrates, *The Second International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT2015), No.Pos1.24,* Hamamatsu, Aug. 2015.
170. **Keisuke Murakumo, Yuya Yamaoka, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoconductivity with 1.55 m excitation of InAs QDs embedded in InGaAs barriers on GaAs substrate, *2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015), No.PS-7-9,* Sapporo, Sep. 2015.
171. **Hiroto Ota, Chiho Harayama, Tomohisa Maekawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of Two-Color Surface Emitting Device of a Coupled Cavity Structure with InAs QDs Formed by Wafer-Bonding, *2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015), No.A-7-6,* Sapporo, Sep. 2015.
172. **盧 翔孟, Akihiro Kawaguchi, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Temperature dependence photoluminescence of quantum dots grown on (311)B GaAs by molecular beam epitaxy, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th2-5,* 2015年7月.
173. **Keisuke Murakumo, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** In-plane photoconductivity of InAs QDs layers embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-10,* 2015年7月.
174. **Hiroto Ota, Chiho Harayama, Tomohisa Maekawa, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Fabrication of Two-Color Surface Emitting Laser of a Coupled Cavity Structure Formed by Wafer-Bonding, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-12,* 2015年7月.
175. **Tomohisa Maekawa, Chiho Harayama, Hiroto Ota, 北田 貴弘, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** Two-color emission from coupled cavity structure including InAs QDs formed by wafer bonding, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-13,* 2015年7月.
176. **太田 寛人, 原山 千穂, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光素子の発光特性, *2015年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Ca-2,* 2015年8月.
177. **村中 隆二, 大正谷 皓司, 岡本 敏弘, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属電極に作製したマルチスリット構造によるLED取り出し光の集光特性に関する研究, *2015年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会, No.Ap-9,* 2015年8月.
178. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** テラヘルツ波検出に向けた量子ドット層の面内光伝導特性評価, *第3回 光・ナノテクノロジー研究会 和歌山大・徳島大合同,* 2015年8月.
179. **太田 寛人, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** テラヘルツLEDのための二波長面発光レーザの作製, *第3回 光・ナノテクノロジー研究会 和歌山大・徳島大合同,* 2015年8月.
180. **井須 俊郎, 太田 寛人, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘 :** 半導体多層薄膜結合共振器構造によるテラヘルツ発光素子, *2015年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* **Vol.CI-1-3,** 2015年9月.
181. **盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (001)と(113)B GaAs 基板上に成長したInAs 量子ドットに対するSb 照射の効果, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.14p-2W-7,* 2015年9月.
182. **熊谷 直人, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 結合共振器を用いた二波長面発光レーザの発振スペクトル注入電流依存性, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.15p-2C-5,* 2015年9月.
183. **太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InGaAs/GaAs 多重量子井戸構造を導入した結合共振器による二波長面発光レーザの発振特性, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.16a-2E-7,* 2015年9月.
184. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 1.5・m パルス励起によるInAs 量子ドット光伝導アンテナ構造の光電流, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.16p-2J-11,* 2015年9月.
185. **北田 貴弘, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器を用いた面型発光素子「テラヘルツLED」の開発, *応用物理学会・テラヘルツ電磁技術研究会 第1回研究討論会/テラヘルツテクノロジーフォーラム 第1回テラテク技術セミナー,* 2015年10月.
186. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 熊谷 直人, 盧 翔孟 :** 半導体ナノ構造による新規光デバイスの創製, *徳島大学&宇都宮大学光学連携講演会2015,* 2015年10月.
187. **太田 寛人, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器を用いた二波長面発光レーザー, *レーザー学会学術講演会第36回年次大会,* 2016年1月.
188. **森田 健, 奥村 朗人, 石谷 善博, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 時間分解ファラデー回転法によるInGaAs/InAlAs多重量子井戸における電子g因子測定, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.19p-W241-8,* 2016年3月.
189. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Er ドープInAs 量子ドット層のキャリア緩和時間から評価した光電流周波数特性, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.20a-H135-8,* 2016年3月.
190. **太田 寛人, 西村 信耶, 渡邊 健吉, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合により形成した結合共振器による二波長面発光レーザの特性, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.20p-S321-3,* 2016年3月.
191. **盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速波長変換素子に向けたInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜三結合共振器, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.21p-S621-2,* 2016年3月.
192. **北田 貴弘, 太田 寛人, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 結合共振器から生じる二波長レーザー光の時間的コヒーレンスの評価, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.21p-S621-6,* 2016年3月.
193. **北田 貴弘, 太田 寛人, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** テラヘルツLED, *LED総合フォーラム2015,* **Vol.P-3,** 2015年12月.
194. **村中 隆二, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 原口 雅宣 :** 金属電極に作製したマルチスリット構造によるLED取り出し光の集光特性に関する研究, *LED総合フォーラム2015in徳島 論文集,* 85-86, 2015年12月.